問題1

I. 図1および図2のように、誘電率 ϵ_0 の真空中に半径aと3aの極めて薄い導体球殻AとBが同心状に置かれ、その間には半径2aの同心球面を境に誘電率 3ϵ と ϵ の誘電体が満たされている。ここで、球殻Aの電荷を q_A とする。ただし、問(3)–(5)では解答に q_A を用いてはならない。また、無限遠の電位を0とする。

まず、図1のように球殻Bを接地し、球殻Aに電圧 V_0 (> 0)を印加した。以下の問に答えよ。

- (1) 球殻の中心から距離rにおける電界の大きさを、 q_A を用いて表せ、
- (2) q_A と V_0 の関係を求めよ.
- (3) 球殻の中心から距離rにおける電位を求め、rに対する電位のグラフを描け.

次に、図 2 のように球殻 A を接地し、球殻 B に電圧 V_0 (> 0)を印加した. 以下の問に答えよ.

- (4) 球殻 B の電荷を求めよ.
- (5) この系に蓄えられた静電エネルギーを求めよ.

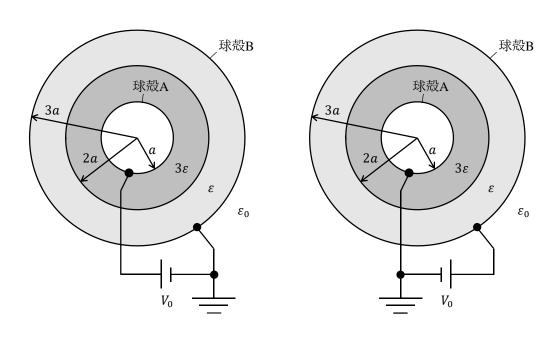


図 1

図 2

II. 図 3 のように、真空中 (誘電率 ϵ_0 、透磁率 μ_0) に完全導体からなる半径aおよびb (a < b) の無限に長い二つの導体円筒 M, N が同軸に配置されている。円筒の軸をz軸とする。円筒 M, N の厚みは無視できる。二つの導体円筒のz軸方向単位長さ当りの静電容量、自己イン ダクタンスを、それぞれCおよびLとする、以下の問に答えよ、

必要であれば、円筒座標系 (r,θ,z) における以下のベクトル解析の公式を用いて良い.

$$\mathrm{grad}\ f = \frac{\partial f}{\partial r} \boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \boldsymbol{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \boldsymbol{e}_z\ , \ \mathrm{div}\ \boldsymbol{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\ ,$$

$$\text{rot } \boldsymbol{A} = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_{\theta}}{\partial z}\right]\boldsymbol{e}_r + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\boldsymbol{e}_{\theta} + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_{\theta}) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\boldsymbol{e}_z$$

- (1) M および N をz軸方向単位長さ当りそれぞれ λ , $-\lambda$ の電荷で一様に帯電させた. その ときに形成される電界Eを円筒座標系で表せ、また、静電容量Cを求めよ、
- (2) MおよびNにz軸方向にそれぞれに一様な直流電流 +Iおよび-Iを流した. そのときに 形成される磁束密度Bを円筒座標系で表せ、また、自己インダクタンスLを求めよ、

次に電流が時間変化する場合を考える, 時刻t, 位置zにおける M と N の電位差をV(z,t), M および N にz軸方向に流れる電流をそれぞれ +I(z,t)および-I(z,t)とする.

- (3) V(z,t)のz軸方向の変化とI(z,t)の時間変化の関係を表す微分方程式を求めよ. C, Lを 用いてよい。
- (4) I(z,t)のz軸方向の変化とV(z,t)の時間変化の関係を表す微分方程式を求めよ. C, Lを 用いてよい.
- (5) 問(3) (4)の結果から、V(z,t)およびI(z,t)がz軸方向に真空中の光速cで伝搬することを 示せ.

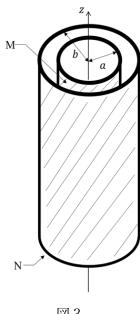


図3